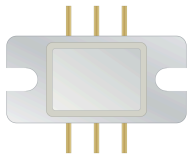
2000–8500 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 41 dBm (typisch)

LCI-PA-2000-8500-PS41T · 2000–8500 MHz · GaN Gehäuster Leistungsverstärker.



Kennwerte der RF-Tabelle: PSAT 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 15 dB (typisch); PAE 35 % (typisch). RF-Prüfbedingungen: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 26 dBm; PW = 100 µs; D = 10%.

CMW010B

Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Gehäuseabmessungen: 18.03 × 8.7 mm.

RF-Kennwerte

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 26 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	2000	-	8500	MHz
Sättigungsausgangsleistung	-	40.3	41	-	dBm
Leistungsverstärkung	-	14.3	15	-	dB
Leistungsaddierte Effizienz	-	25	35	-	%
Welligkeit der Leistungsverstärkung	-	-	-	1.5	dB
Kleinsignalverstärkung	-	20	22	24	dB

DC-Bias und Strom

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Drainspannung	-	-	-	-	28	V
Gatespannung	-	-	-	-	-2.6	V
Ruhestrom	-	-	-	-	0.9 (Vd = 28 V)	A

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	-	-	-	32	V
Minimale Gate-Vorspannung	-	-5	-	-	V
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	30	dBm
Maximale Kanaltemperatur	-	-	-	200	°C

Gehäuseabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Gehäuseabmessungen	18.03 × 8.7	mm
Anschlussspannweite	14.7	mm

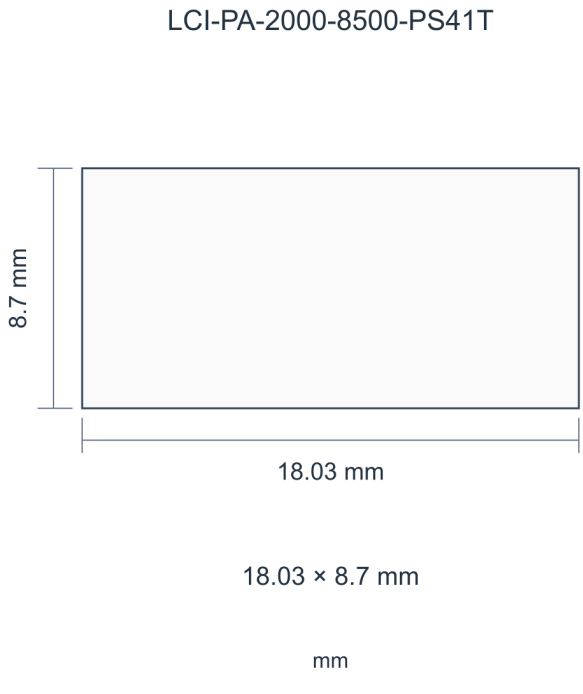
Aktueller Publikationsstand · 1.7 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.6.

Integrationshinweise

CMW010B Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Mechanische Maßzeichnung

Teilzeichnung mit bestätigten Abmessungen in mm. Für die Montage ist der vollständige Montageplan erforderlich.

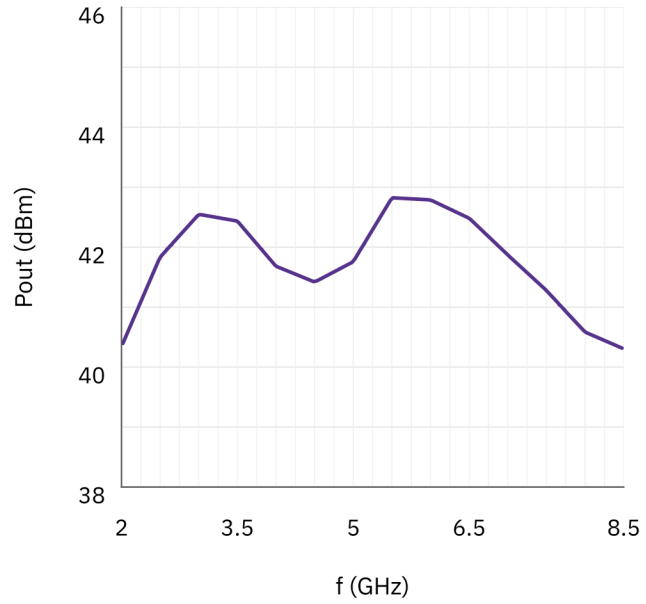


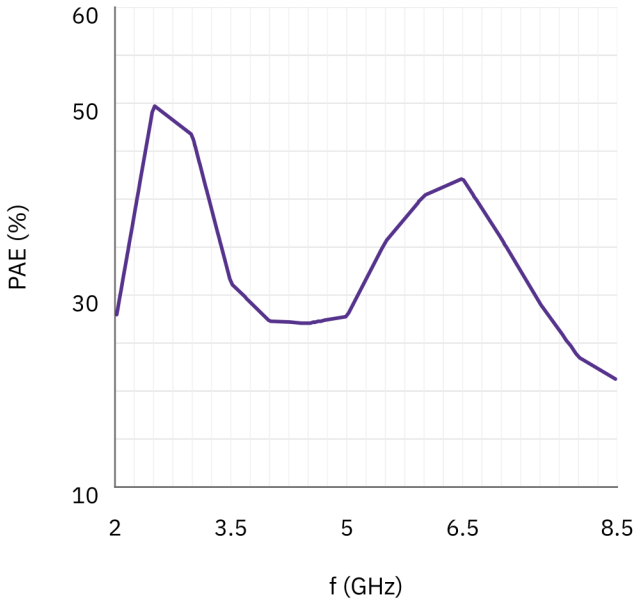
Kennlinien

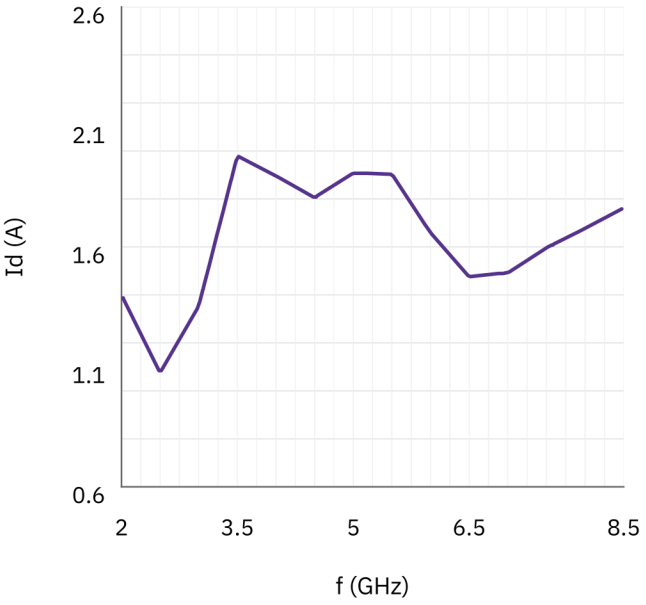
Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.

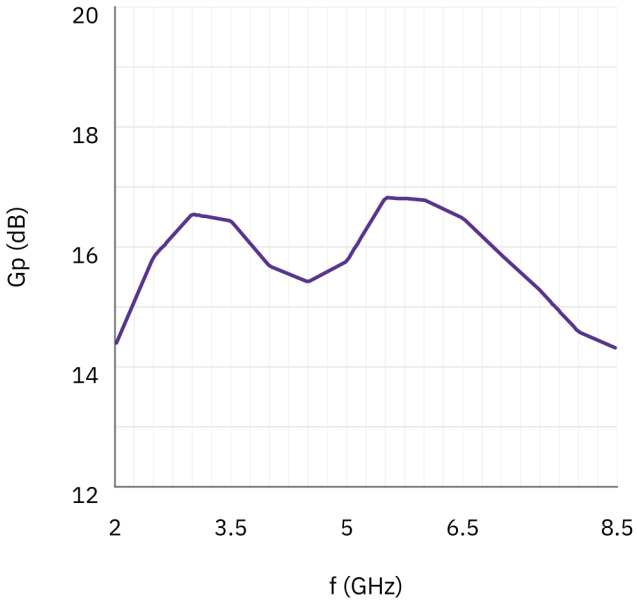
Gepulst — Ausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Dynamischer Drainstrom; Leistungsverstärkung.

Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V; Pin=26dBm. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. τ = 100 µs; D = 10%.



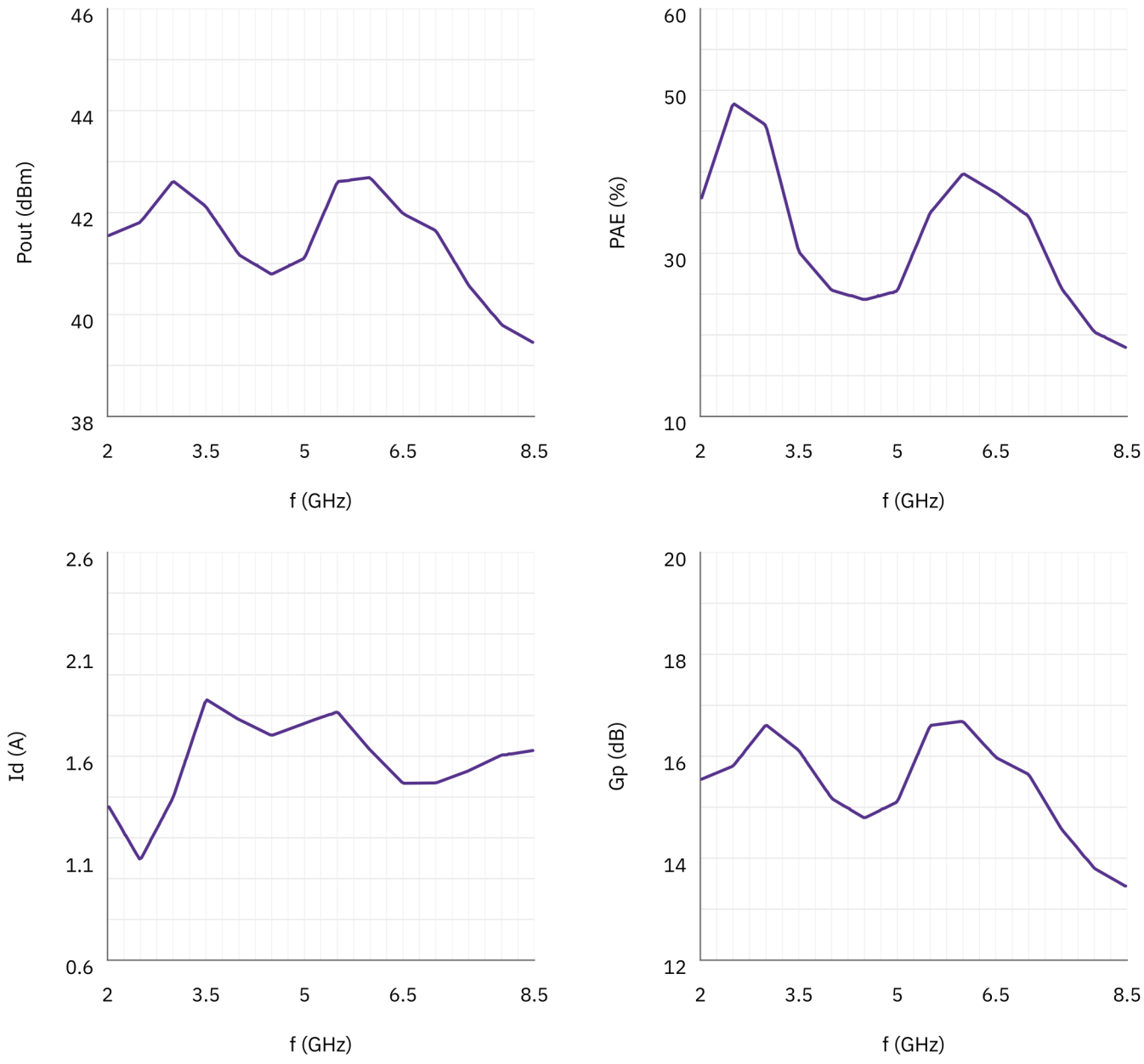






Dauerstrich (CW) — Pout; PAE; Id; Gp.

Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V; Pin=26dBm. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. Das obere linke Diagramm zeigt Pout in dBm, das untere rechte Gp in dB.



Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.